

а 2011 0026

Изобретение относится к способам получения полупроводниковых материалов и может быть использовано в полупроводниковой технологии.

Способ устранения деформации монокристаллов ZnSe в процессе охлаждения после роста, выращенных из газовой фазы, на плоском с произвольной толщиной дне закрытой камеры для роста, состоит в использовании температуры роста, находящейся в диапазоне 900...1100°C, градиента температуры в области кристаллизации 0...5°C/см, скорости нагрева зародыша кристаллизации и охлаждения выращенного кристалла 20...60°C/час с использованием специального профиля температуры печи, необходимым для устранения эффекта прилипания кристалла к стенкам ампулы.

П. формулы: 1

Фиг.: 3